



公益社団法人応用物理学会 応用電子物性分科会主催
応用電子物性分科会研究例会

ウェハ接合技術の最前線

◇日時: 2025年6月27日(金) 13:00~17:00

◇場所: 御茶ノ水トライエッジカンファレンス(<http://try-edge.infield95.com/>)

ウェハ接合(貼り合わせ)技術、特に低温(常温)でのウェハ接合技術は「ヘテロジニアスインテグレーション」「チップレット」等、将来の半導体産業における材料・素子・実装のそれぞれにおいてイノベーションをもたらす技術として世界的に注目されています。本研究例会では、次世代のエレクトロニクスにおけるキーテクノロジーであるウェハ接合研究の第一線で活躍されている研究者を講師としてお招きし、そのメカニズムと応用の両側面から議論します。皆様奮ってご参加ください。

応用電子物性分科会 幹事長 挨拶 (13:00-13:10)

1. 13:10-13:50 常温接合技術の基礎—表面活性化接合 須賀 唯知 (明星大/東京大)
 2. 13:50-14:30 常温接合技術の基礎—原子拡散接合 島津 武仁 (東北大)
 - 14:30-14:50 休憩
 3. 14:50-15:30 ウェハ接合技術の応用—3次元LSI 福島 誉史 (東北大)
 4. 15:30-16:10 半導体積層技術を用いたCMOSイメージセンサの進化 藤井 宣年 (ソニー)
 5. 16:10-16:50 ウェハ接合技術の応用—VCSEL/MEMS集積 石田 周太郎 (サンテック)
- 閉会 (16:50-17:00)
-

■ 受付: [こちら](#) のイベント登録サイトより事前登録をお願いいたします。

■ 参加費(テキスト代・消費税込):

応用電子物性分科会会員 3,000 円

応用物理学会会員(分科会非会員) 7,000 円

応用物理学会会員(シニア会員) 2,000 円

一般 12,000 円, 一般学生 1,000 円

*応電分科会の賛助会員の方は 1 社につき 1 名まで無料。2 名以上は通常通りの参加費。

*応電分科会幹事は無料。

■ 問合せ先:

重川 直輝 (大阪公立大)

E-mail: shigekawa@omu.ac.jp

高橋 一浩 (豊橋技科大)

E-mail: takahashi@ee.tut.ac.jp

横関 弥樹博 (ソニー)

E-mail: Mikihiro.Yokozeki@sony.com

吉田 千秋 (応用物理学会 事務局) E-mail: divisions@jsap.or.jp TEL: 03-3828-7723(直通)
(スパム対策のため、上の“@”は全角になっています。半角の“@”に置き換えて下さい。)

応用電子物性分科会ホームページ: <http://annex.jsap.or.jp/ohden/>